

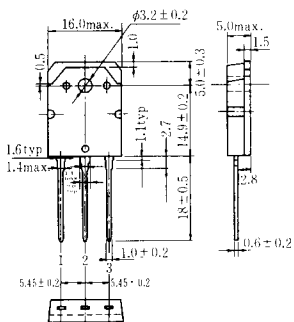
2SD1453

シリコン NPN 三重拡散形

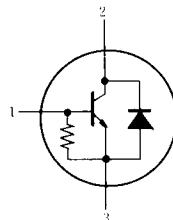
V水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース:Base
 2. コレクタ:Collector
 3. エミッタ:Emitter
- (Dimensions in mm)



(TO-3P)

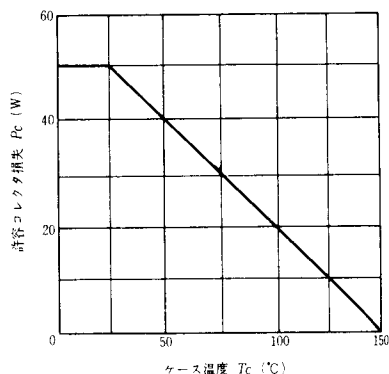
絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	Symbol	2SD1453	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	3	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	3.5	A
サージコレクタ電流	$i_{C(surge)}$	10	A
ダイオード順方向電流	I_D	3.5	A
許容コレクタ損失	P_C^*	50	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	°C

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値。

* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ遮断電流	I_{CES}	$V_{CE}=1500\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	0.5	mA
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=200\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$	—	—	5.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$	—	—	1.5	V
エミッタ・コレクタダイオード電圧	V_{ECF}	$I_F=3\text{A}$	—	—	2.2	V
下降時間	t_f	$I_{CP}=2.75\text{A}, I_{B1}=0.6\text{A}, I_{B2}=-1.3\text{A}$	—	—	0.8	μs